

Procedeu de obținere a nanostructurilor semiconductoare ce include depunerea unei măști pe una din suprafețele unei plăci semiconductoare, implantarea ionilor, tratarea electrochimică și înlăturarea măștii, caracterizat prin aceea că implantarea ionilor se efectuează la o energie a ionilor de până la 30 keV, cu o doză de până la  $10^{11}$  cm<sup>-2</sup>, iar tratarea electrochimică se efectuează la trecerea curentului cu o densitate de cel puțin 100 mA/cm<sup>2</sup>.